Медведев А.М. Сборка и монтаж электронной аппаратуры. [Тескт] А.М. Медведсв. – М.: Техносфера, 2007 – 208 с.

РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН СТОЛБОМ ПЛАЗМЫ

С.А. Маркелов, М.Г. Иванов, Г.О.Черкасов Самарский государственный аэрокосмический университет, г.Самара

В последнее время резко возросло значение электромагнитной совместимости совместно работающих электронных и радиоэлектронных средств. Основными источниками индустривлымих помех в крупных городах являются люминесцентные источники освещения, предствадиющие собой слобы плажны, окруженные люминофором. Для исследования илумовых свейств таких светильников на радиотехническом факультете СГАУ в рамках диспилины «Электромагнитная совместимость» существует соответствующая лябораторная работа. В настоящее время проводится модификация этой работы, направленная на изучение влияния режима работы лампы на се шумовые свойства. При этом стояб плажим моделируетска:

-диэлектрическим стержнем радиусом R,

-диэлектрической проницаемостью
$$\varepsilon' = \varepsilon_0 - \frac{n\varepsilon^2}{m\omega^2}$$
,

-проводимостью $g = -j\omega \frac{ne^2}{m_{ch}^2}$ (соотношение Эккле [1]),

где ε $_0$ — диэлектрическая постоянная вакуума, h — концентрация носителей зарядов, m — масса электрона, e — заряд электрона, ω — рабочая частота.

Задачей лабораторных исследований является установление связи тока через лампу с диэлектрической проницаемостью є и проводимостью g.

В настоящем докладе представлены результаты модификации лабораторной работы. Теория метода измерения диздектрической пронидаемости в и проводимости g разработана С.А. Маркеловым, экспериментальные исследования выполнены М.Г. Изановым и Г.О. Черкасовым.

Для диагностики плазмы (определения ε и g) использовался СВЧ метол, основанный на измерении элементов диаграммы обратного рассениям (ДОР), для чего столб плазмы (люминесцентный источник освещения) облучался электромагнитным полем мощностью 1 мкВт в 3-см диапазоне длин волн и определялся элемент Γ₁₁ диаграммы обратного рассеяния. т.е. рассеяный обратный поток с той же поляриалией (в эксперименте — вертикальной), что и поток падающей волны.

Для анализа процесса рассеяния использовался метод самосогласованного поля, в основе которого в данном случае лежит электродивливиеский расчет двух изначально независимых процессов – павение электроманияться выплачания обратное рассеяние электромагнитной волны столбом плазмы. Спидва эти два решения, находим амплитуду и фалу коэффициента отражения Г. Для этого мы раскладываем рассеянное поле по системе функций Ханкела, откуда находится амплитуда поля на поверхности сголба, что и позволяет спильть два решения. Кроме того обеспечивается выполнение граничных условий на поверхности столба, что и позволяет смильть два решения. Кроме того обеспечивается выполнение граничных условий на поверхности отлаба, по два решения.

Таким образом, студентам достаточно найти в ходе лабораторной работы связь тока через лампу с коэффициентом отражения Г, измеряемым при помощи измерительной линии, а при подготовке отчета по лабораторной работе – рассчитать параметры плазмы.

Предложенный метод может использоваться и в других задачах диагностики плазмы.

Список использованных источников
1 Г. Мирдель. Электрофизика, Москва изд-во; Мир. 1972.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ВОКРУГ НЕОДНОРОДНОГО ТЕЛА В ИОНОСФЕРНОЙ ПЛАЗМЕ

А.Н. Овсянников ¹

¹ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»

Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара

Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самар

Пехнические требования к вновь разрабатываемым космическим аппаратам задают дингельный срок активного существования, с увеличением которого все большее значение приобретает проблема анализа и протнозирования электростатической обстановки возле поверхности аппарата. Нарастание абсолютной величины поверхностного потенциала увеличивает вероитность электростатического разрада (ЭСР) в окружающую плазму, а лифференциальное нарастание потенциала на соседних участках может вызывать ЭСР между ними: эти явления мотут причинить повреждения различной степения влиять до потено КА (1).

Информация об ожидаемом распредолении заряда и потенциала по поверхности КА необходима уже на стадии его проектирования, когда возможен только расчет характеристик. Поверхность КА неоднородна, и из-